ЭЛЕКТРОННЫЕ СВОЙСТВА НАНОТРУБОК СИЛИЦИДА КАЛЬЦИЯ

Алексеев А.Ю.

Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники г. Минск, Республика Беларусь

Мигас Д.Б. – д-р физ.-мат. наук, доцент

Результаты моделирования с помощью методов из первых принципов показали возможность формирования нанотрубок Ca₂Si. Установлено, что ширина их запрещённой зоны уменьшается с уменьшением диаметра нанотрубки и принимает значения от 0,69 эВ (ширина запрещённой зоны двумерного Ca₂Si) и менее. В отличие от двумерного Ca₂Si, нанотрубки Ca₂Si кресельного типа являются прямозонными полупроводниками, что открывает для них перспективы в оптоэлектронике.

В последние десятилетия интенсивно изучаются наноструктуры различных материалов, так как они могут обладать уникальными свойствами из-за влияния эффектов квантового ограничения и доминирования поверхностных свойств над объемными. Среди них нанотрубки образуют большой класс наноструктур, привлекательный в связи с их структурными особенностями, которые также влияют на электронные свойства в зависимости от диаметра и хиральности [1,2]. По определению, нанотрубки – это свёрнутые в трубку наноленты (полоски), вырезанные из бесконечного двумерного материала. Недавно было теоретически предсказано существование двумерных силицидов, германидов и станнидов щёлочноземельных металлов, которые являются полупроводниковыми материалами с шириной запрещённой зоны (ШЗЗ) 0,1-1,0 эВ [3,4]. Установлено, что когда в роли щёлочноземельного металла выступали Са, Sr или Ва, предсказанные структуры оказались динамически стабильны в фазе T, а когда Mg – в фазе Td. Фазы T и Td соответствуют аналогичным фазам двумерных дихалькогенидов тугоплавких металлов [5]. Как и в случае дихалькогенидов тугоплавких металлов [2] не исключено, что сворачивая наноленты найденных двумерных материалов [3,4] в нанотрубки можно получить наноструктуры с новыми свойствами. В данной работе на примере Ca₂Si были исследованы возможность формирования нанотрубок из этого силицида и особенности их зонных структур.

Моделирование проводилось в рамках теории функционала плотности в коде VASP [6] с использованием приближения Пердью-Бурке-Эрнцерхофа для обменно-корреляционного потенциала [7]. Для расчётов использовалась энергия отсечки для базиса плоских волн 307 эВ и сетка точек в обратном пространстве 1×1×15. Расчёт проведён для трёх нанотрубок типа зигзаг ((10,0), (12,0) и (14,0)) и трёх нанотрубок кресельного типа ((6,6), (8,8) и (9,9)) с диаметрами в диапазоне 15,6–23,6 Å. Их сечения, а также вид сбоку представлены на боковых панелях рисунка 1. Была проведена полная структурная оптимизация исследуемых нанотрубок. Поскольку в пределе бесконечного диаметра нанотрубка физически эквивалентна двумерной структуре, обнаружено, что все рассчитанные величины, включая полные энергии структур, структурные параметры и ШЗЗ, при увеличении диаметра стремятся к соответствующим величинам двумерного материала.

Разность полной энергии нанотрубки, рассчитанной на одну структурную единицу, и полной энергии соответствующего двумерного материала называется энергией напряжения нанотрубки. Чем она больше, тем больше энергии необходимо затратить для сворачивания наноленты в нанотрубку (наличие оборванных связей в наноленте, однако, может привести к тому, что при её сворачивании в нанотрубку энергия высвобождается [8]). Энергия напряжения положительна и обратно пропорциональна квадрату диаметра нанотрубки в случаях, когда сворачиваемый двумерный материал имеет ось симметрии второго порядка в плоскости двумерного материала, что справедливо для графена, двумерных дихалькогенидов тугоплавких металлов, исследуемых в данной работе материалов и других, но не справедливо, например, для имоголита [9]. Установлено, что изменение энергии напряжения в нанотрубках Ca_2Si также обратно пропорционально квадрату диаметра и находится в диапазоне значений 0,03-0,11 эВ, а сама энергия напряжения примерно в два раза меньше, чем энергия напряжения нанотрубок MoS_2 [10]. Поскольку нанотрубки MoS_2 уже были синтезированы ранее [2], меньшая энергия напряжения нанотрубок Ca_2Si позволяет сделать вывод о возможности их формирования. Энергия напряжения нанотрубок Ca_2Si кресельного типа оказалась незначительно ниже, чем для нанотрубок типа зигзаг (на 0,03 эВ между нанотрубками (10,0) и (6,6) и на 0,003 эВ между нанотрубками (14,0) и (8,8)).

Зонные структуры и соответствующие ШЗЗ представлены на центральной панели рисунка 1. Для сравнения, рассчитанная тем же методом ШЗЗ двумерного Ca₂Si равна 0,35 эВ. Таким образом, было обнаружено, что ШЗЗ уменьшается при уменьшении диаметра нанотрубки. Более того, непрямозонный двумерный Ca₂Si [4] становится прямозонным после его сворачивания в нанотрубку кресельного типа. Такая же тенденция изменения ШЗЗ и изменение характера первого перехода при изменении хиральности нанотрубки уже наблюдалась для нанотрубок дихалькогенидов тугоплавких металлов [10]. Наши расчёты не выявили зависимости длины связи Si–Ca от диаметра нанотрубки. Не исключено, что изменение зонных структур нанотрубок Ca₂Si обусловлено изменением углов между химическими связями в исследуемых структурах. Следует отметить, что тенденции изменения ШЗЗ одинаковы для нанотрубок обеих хиральностей – разность между ШЗЗ нанотрубок примерно одного диаметра постоянна и равна 0,03 эВ. Известно, что используемый метод расчёта обменнокорреляционной энергии недооценивает ШЗЗ. ШЗЗ двумерного Ca₂Si, рассчитанная более точно с использованием гибридного потенциала, равна 0,69 эВ [4], поэтому следует полагать, что рассчитанные в работе значения будут ближе к экспериментальным значениям, если их увеличить на 0,34 эВ.



Рисунок 1 – Боковые панели: внешний вид зигзаг (14,0) и кресельных (8,8) нанотрубок Ca₂Si (тёмные шары – атомы Ca, светлые шары – атомы Si). Центральная панель: зонные структуры нанотрубок Ca₂Si. Ноль на шкале энергии соответствует потолку валентной зоны. Диаметры (*d*) нанотрубок, первые переходы и ширины запрещённых зон также указаны

Таким образом, показана возможность формирования полупроводниковых нанотрубок Ca₂Si с различной хиральностью. Выявлен прямозонный характер запрещенной зоны у энергетически более стабильных нанотрубок кресельного типа, что подразумевает перспективы их применения в оптоэлектронике. В связи с тем, что свойства силицидов, германидов и станнидов кальция, стронция и бария похожи, следует ожидать те же тенденции и для нанотрубок остальных соединений из этого ряда. В то же время, нанотрубки Mg₂Si, Mg₂Ge и Mg₂Sn могут обладать существенно отличными свойствами, как это имеет место в случае двумерных материалов, что требует дополнительного изучения.

Список использованных источников:

1. Saito, R. Physical properties of carbon nanotubes / R. Saito, G. Dresselhaus, M. S. Dresselhaus – London : Imperial College Press, 1998. – 259 p.

- 2. Tenne, R. Inorganic nanotubes / R. Tenne, C. N. R. Rao // Philosophical Transactions of the Royal Society of London. Series A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences. 2004. Vol. 362, № 1823. P. 2099–2125.
- 3. Stability of 2D Alkaline-Earth Metal Silicides, Germanides and Stannides / A. Yu. Alekseev [et al.] // International Journal of Nanoscience. 2019. Vol. 18, № 03n04. P. 1940013.
- 4. Structural stability and electronic properties of 2D alkaline-earth metal silicides, germanides, and stannides / A. Y. Alekseev [et al.] // Japanese Journal of Applied Physics. 2020. Vol. 59. P. SF0801.

5. Calandra, M. Chemically exfoliated single-layer MoS₂: Stability, lattice dynamics, and catalytic adsorption from first principles. M. Calandra // Physical Review B. – 2013. – Vol. 88, № 24. – P. 245428.

6. Kresse, G. Efficiency of ab-initio total energy calculations for metals and semiconductors using a plane-wave basis set / G. Kresse, J. Furthmüller // Computational Materials Science. – 1996. – Vol. 6, № 1. – P. 15–50.

7. Perdew, J. P. Generalized gradient approximation made simple / J. P. Perdew, K. Burke, M. Ernzerhof // Physical review letters. – 1996. – Vol. 77, № 18. – P. 3865–3868.

8. Seifert, G., Köhler, T., & Tenne, R. (2002). Stability of metal chalcogenide nanotubes. The Journal of Physical Chemistry B, 106(10), 2497-2501.

9. Guimarães, L., Enyashin, A. N., Frenzel, J., Heine, T., Duarte, H. A., & Seifert, G. (2007). Imogolite nanotubes: stability, electronic, and mechanical properties. Acs Nano, 1(4), 362-368.

10. Seifert, G. Structure and electronic properties of MoS₂ nanotubes / G. Seifert [et al.] // Physical Review Letters. – 2000. – Vol. 85, № 1. – P. 146.